

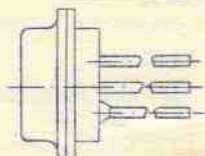
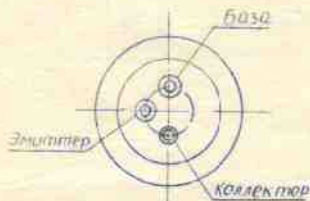


Транзисторы 2Т312А,  
2Т312В,  
2Т312В

### ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планирные п-р-п транзисторы типов 2Т312А, 2Т312В, 2Т312В в металлоглазном корпусе, предназначенные для работы в аппаратуре специального назначения.

Климатическое исполнение общиное.



Масса не более 1г.

### ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25°С

| Наименование параметра, режим измерения, единица измерения  | Буквенные обозначения | Норма    |       |          |       |          |       |
|---|-----------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|   |                       | 2Т312А   |       | 2Т312В   |       | 2Т312В   |       |
|   |                       | не менее | более | не менее | более | не менее | более |
| I   | 2                     | 3        | 4     | 5        | 6     | 7        | 8     |
| Обратный ток коллектора, мкА<br>( $I_{K0}$ - 30В)   | $I_{K0}$              |          | 1     |          | 1     |          | 1     |
| Статический коэффициент переноса тока в схеме с общим эмиттером ( $I_{K0} = 2В$ , $I_B = 20\mu A$ , $R = 10-100\Omega$ , $f = 50-1000\Gammaц$ ) | $h_{213}$             | 12       | 100   | 25       | 100   | 50       | 250   |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ( $I_K = 20\mu A$ , $I_B = 2\mu A$ )  | $U_{K3нас}$           |          | 0,5   |          | 0,5   |          | 0,35  |
| Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте<br>( $U_{K0} = 10В$ , $I_B = 5\mu A$ , $f = 20\text{МГц}$ )                                | $h_{213}$             | 4        |       | 6        |       | 6        |       |

| T  | 2          | 3  | 4   | 5  | 6   | 7  | 8   |
|--|------------|----|-----|----|-----|----|-----|
| Постоянное время (при обратной связи, по $V_{ce}=10В, I_3=5мА, f=5МГц$ ) | $Z_c$      |    | 500 |    | 500 |    | 500 |
| Обратный ток эмиттера, мкА ( $V_{ce}=4В$ )                               | $I_{300}$  |    | 10  |    | 10  |    | 10  |
| Время рассасывания, нс ( $I_c=20мА, I_{c1}=2мА, I_{c2}=14мА$ )           | $t_{рас}$  |    | 100 |    | 130 |    | 130 |
| Скорость коллекторного перехода, пс ( $V_{ce}=10В, f=5МГц$ )             | $C_c$      |    | 5   |    | 5   |    | 5   |
| Скорость эмиттерного перехода, пс ( $V_{ce}=1В, f=5МГц$ )                | $C_e$      |    | 20  |    | 20  |    | 20  |
| Напряжение насыщения база-эмиттер, В ( $I_c=20мА, I_b=2мА$ )             | $V_{кэнт}$ |    | 1,1 |    | 1,1 |    | 1,1 |
| Граничное напряжение, В ( $V_{кв}=30В, I_3=7,5мА$ )                      | $V_{квкп}$ | 30 |     | 30 |     | 30 |     |

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ:

Золото 10,027 мг

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типа 2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В соответствуют техническим условиям ЭИЗ.365.143 ТУ и габаритному чертежу ЭИЗ.365.143 ГЧ.

Принято по извещению № 274 от 12-04

